

全新推薦！新產品

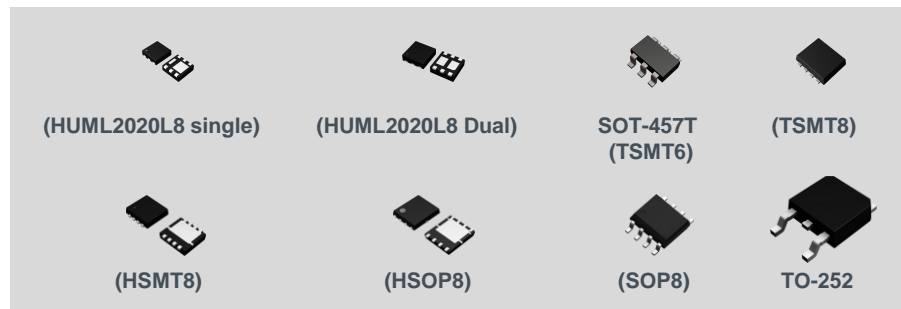


領先業界的超低導通電阻Pch MOSFET登場

適用於-40V/-60V工控裝置的 Pch MOSFET

第五代 Pch 功率MOSFET單極型系列/第五代 Pch 功率MOSFET雙極型系列

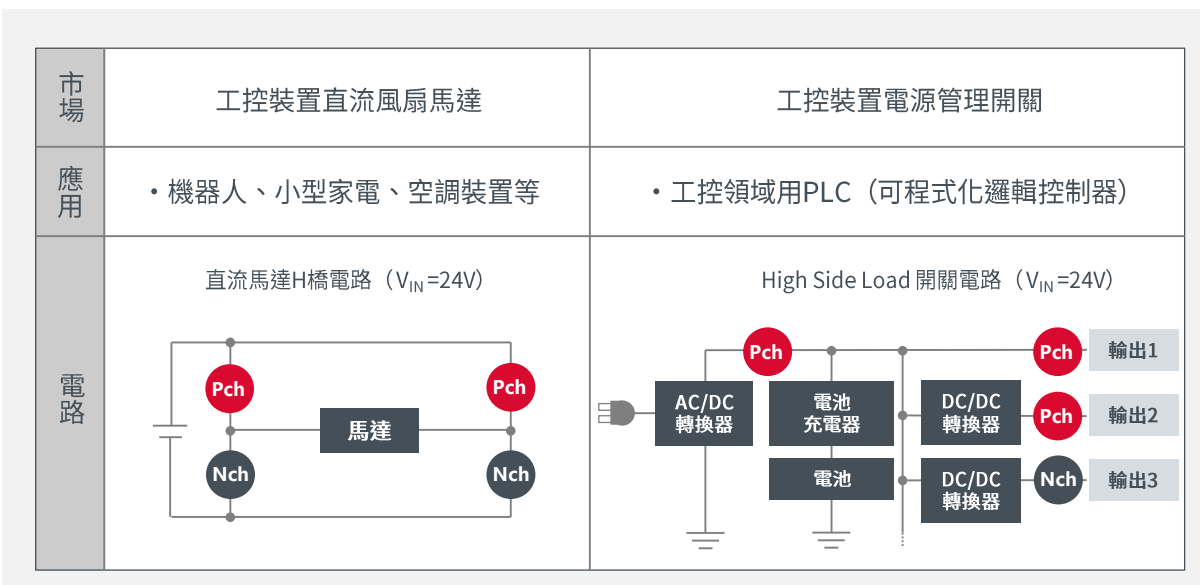
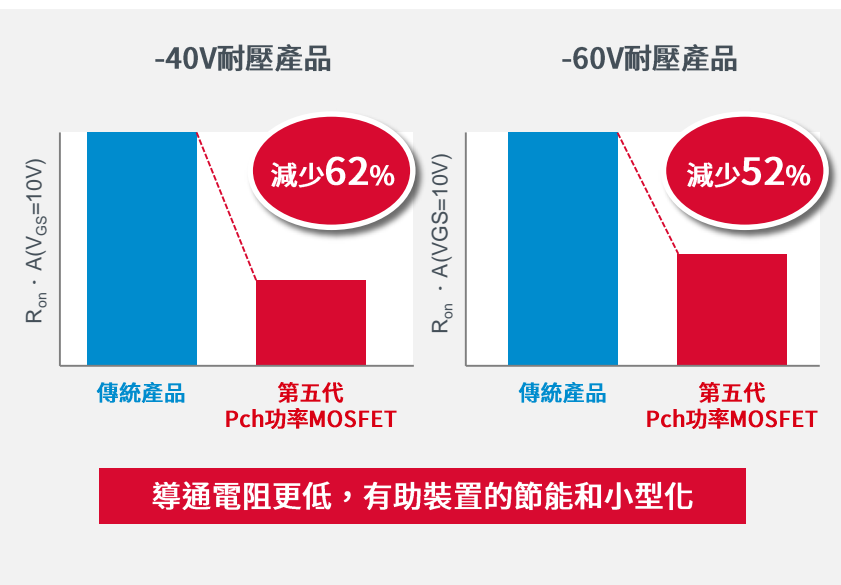
- 領先業界的超低 $R_{on} \cdot A$ （單位面積的 R_{on} ），有助裝置的節能和小型化
- 新設計的微細溝槽結構可避免氧化膜被破壞，有效提升品質
- 豐富多元的封裝陣容，其中包括單極型18款機型和雙極型6款機型，有助減少設計工時並提高可靠性



備註：封裝採用JEDEC標準。()內表示ROHM封裝。

■傳統產品與新產品的導通電阻比較

■支援應用和使用電路



<單極系列產品陣容>

封裝名稱	封裝尺寸 (mm)	V _{DSS} (V)	電流值(A) T _c =25°C								內部電路圖
			0	-5	-10	-15	-35	-55	-75	-80	
<DFN2020-8S> (HUML2020L8 single)	2.0×2.0×0.6	-40	RF4G060AT -6*								
		-60	RF4L040AT -4*								
SOT-457T (TSMT6) [SC-95]	2.8×2.9×0.85	-40	RQ6G050AT -5*								
		-60	RQ6L035AT -3.5*								
(TSMT8)	2.8×3.0×0.8	-40	RQ7G080AT -8*								
		-60	RQ7L050AT -5*								
(HSMT8)	3.3×3.3×0.8	-40	RQ3G110AT -35								
		-60	RQ3L070AT -25								
(HSOP8)	6.0×5.0×1.0	-40	RS1G201AT -78								
		-60	RS1L151AT -56								
(SOP8)	6.0×5.0×1.75	-40	RS3G160AT -16*								
		-60	RS3L110AT -11*								
TO-252 <DPAK>	10.0×6.6×2.3	-40	RD3G01BAT -15								
			RD3G03BAT -35								
			RD3G07BAT -70								
		-60	RD3L01BAT -10								
			RD3L03BAT -35								
			RD3L07BAT -70								

備註：封裝採用JEDEC標準。() 內表示ROHM封裝，[] 內表示JEITA代碼，〈 〉 內表示GENERAL代碼。

*Ta=25°C

<雙極系列產品陣容>

封裝名稱	封裝尺寸 (mm)	V _{DSS} (V)	電流值(A) T _a =25°C			內部電路圖
			0	-5	-10	
<DFN2020-8D> (HUML2020L8 Dual)	2.0×2.0×0.6	-40	UT6JB5 -3.5			
		-60	UT6JC5 -2.5			
(TSMT8)	2.8×3.0×0.8	-40	QH8JB5 -5			
		-60	QH8JC5 -3.5			
(SOP8)	6.0×5.0×1.75	-40	SH8JB5 -8.5			
		-60	SH8JC5 -7.5			

備註：封裝的 () 內表示ROHM封裝，〈 〉 內表示GENERAL代碼。



ROHM Co., Ltd.

21 Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku,
Kyoto 615-8585 Japan

www.rohm.com.tw

本文件所述之產品規格僅供參考。如需實際使用，請另行索取產品規格書。本文資料所引用的數據，皆為謹慎製作，以期達到正確無誤。若萬一因該數據的錯誤/誤植而引起客戶方面的損害，ROHM恕不負責。關於本資料所記載的技術資料，為產品的典型工作方式及應用電路範例，並不表示將原本屬於ROHM或其他公司的智慧財產權藉由銷售該產品明示地或默示地承諾將使用權利轉移給購買者。因使用上述技術資料所發生的紛爭，ROHM恕不負責。本產品為特定機器，裝置所設計的產品，請務必確定該機器及裝置是否受到海關限制出口使用。

本文件內容以2021年 2月 1日為準。

若有產品方面需求請洽